

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2546849

### ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА

Патентообладатель(ли): *Общество с ограниченной ответственностью "СМС тензотерм Рус" (RU)*

Автор(ы): *Каминский Владимир Васильевич (RU), Казаков Сергей Александрович (RU)*

Заявка № 2013130900

Приоритет изобретения **05 июля 2013 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации **04 марта 2015 г.**

Срок действия патента истекает **05 июля 2033 г.**

Врио руководителя Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

*Л.Л. Кирий*





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) **ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(21)(22) Заявка: 2013130900/28, 05.07.2013

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
05.07.2013

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 05.07.2013

(43) Дата публикации заявки: 10.01.2015 Бюл. № 1

(45) Опубликовано: 10.04.2015 Бюл. № 10

(56) Список документов, цитированных в отчете о  
поиске: RU2235316C1, 27.08.2004.  
JP200225775A, 11.09.2002. EP0677741A2,  
18.10.1995. JPS5884129A, 20.05.1983

Адрес для переписки:

143026, Москва, Сколково инновационного  
центра территория, ул. Луговая, 4, корп. 5, офис  
ООО "Центр интеллектуальной собственности  
"Сколково", Котлову Д.В.

(72) Автор(ы):

Каминский Владимир Васильевич (RU),  
Казаков Сергей Александрович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Общество с ограниченной ответственностью  
"СМС тензотерм Рус" (RU)(54) **ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА**(57) **Формула изобретения**

1. Полупроводниковый датчик кислорода, содержащий диэлектрическую подложку и полупроводниковый слой с нанесенными на его поверхность металлическими электродами, отличающийся тем, что полупроводниковый слой выполнен из материала с составом  $Sm_{1-x}Ln_xS$ , где Ln представляет собой один из следующих элементов: La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, а x имеет значение из интервала от 0 до 0,14.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что толщина полупроводникового слоя лежит в пределах от 0,07 мкм до 0,2 мкм.

RU 2 546 849 C 2

Сведения об изменениях или дополнениях  
отражаются в Приложении к патенту

